

日時	講演番号	講演タイトル	講演者名
12/9(水) 15:30~16:30	IA-01	トレンチ構造を持つ縦型二次元正孔ガスタイヤモンドパワー-MOSFETの大電流密度(20 kA/cm ² , 710 mA/mm)・低オン抵抗化(2.5 mΩ cm ²)	角田 隼
	IA-02	低仕事関数金属を用いたn型4H-SiCに対する低ショットキー障壁コンタクトの実現	土井 拓馬
	IA-03	SiO ₂ /SiCゲート界面への応力印加による4H-SiC トレンチMOSFETのチャネル移動度向上	龍島 瑛二
	IA-04	改良高速On-the-fly法によるSiC MOSFETの正確なNBTI評価	坂田 大輝
	IA-05	SiC-MOSFETのユニバーサル移動度の調査に基づく反転層電子の散乱機構の把握	大橋 輝之
	IA-06	4H-SiCにおけるc軸方向の電子移動度の測定と解析	石川 諒弥
	IA-07	熱平衡状態における4H-SiCエピタキシャル層中のシングルショックレー型積層欠陥の挙動および臨界条件の評価	Do Euihyeon
	IA-08	H ₂ エッチング、酸化膜堆積、N ₂ アニールによる4H-SiC/SiO ₂ 界面準位の低減	立木 馨大
	IA-09	4H-SiCウエハエッチングにおける三フッ化塩素ガス分散構造の設計と検証	林 優也
	IA-10	経験的擬ポテンシャル法を用いた4H-SiCにおける浮遊電子状態の計算	永清 幸周
	IA-11	第一原理計算を用いた欠陥のあるGaNの絶縁破壊電界の予測	張 惠
	IA-12	SiC MOSキャパシタへの重イオン照射によるリーク電流の挙動	高橋 美沙
	IA-13	単発バイアス条件におけるIGBTアバランシェ降伏電流からの発光観測	遠藤 幸一
	IA-14	デバイス構造が4H-SiC JFETのMGyガンマ線耐性に及ぼす影響	武山 昭憲
	IA-15	耐放射線イメージセンサに向けたSOI-Si/4H-SiC画素プロセス	目黒 達也
	IA-16	水素ガスアニールに起因したSiO ₂ /GaN界面での異常な固定電荷生成とその物理的起源	溝端 秀聡
	IA-17	機械学習を活用した6インチSiC溶液成長	郁 万成
	IA-18	SiC基板へのAlおよびPイオン注入時の横方向広がり の定量評価	金 祺民
	IA-19	金属マスクを用いたPCVM(Plasma Chemical Vaporization Machining)によるSiCウエハの高効率切断加工に関する検討	中西 悠真
	IA-20	HClガス環境下でのSiC CVD成長の熱力学解析および表面再構成構造の決定	長川 健太
	IA-21	650V SiC-MOSFETのアプリケーション(双方向AC/DCとトータンポールPFC)	向出 徳章
12/9(水) 16:30~17:30	IB-01	SiC結晶中空素空孔センタの量子状態測定	富高 祐哉
	IB-02	高温における4H-SiCのバンド端発光スペクトルの評価	花輪 雅史
	IB-03	パワーデバイス用シリコン基板の照射誘起CO複合体と炭素濃度測定のための赤外吸収	井上 直久
	IB-04	分光イメージングによるGaNデバイスの評価	美里劫 織雅
	IB-05	4H-SiC SJ-UMOSFET内部のキャリアライフタイム分布測定	福井 琢也
	IB-06	FinFET効果による極狭ボディSiC-MOSFETの性能向上	加藤 武寛
	IB-07	4H-SiC 短チャネルn/p MOSFETs における閾値の評価	志摩 拓真
	IB-08	機械学習を用いた断面TEM画像内のSiC MOS界面の決定	吉岡 裕典
	IB-09	不動の基底面転位における可動化の実験的検証	西尾 讓司
	IB-10	4H-SiC CMOS inverters fabricated by ultrahigh-temperature gate oxidation and forming gas annealing	Ayele Kidist
	IB-11	MOVPE成長によるMg添加p型GaNの炭素補償	富田 一義
	IB-12	4H-SiC溶液成長における溶媒添加剤とマクロステップフロー及びバッチングの関係性	三谷 武志
	IB-13	ガス法で成長した4H-SiCバルク結晶中の貫通転位ペアの分布評価	星乃 紀博
	IB-14	ミラー電子顕微鏡分析を用いたSiCウエハ加工品質向上	今藤 修
	IB-15	ミラー電子式検査装置で検出される潜傷のSiCエピタキシャル膜への影響評価	升本 恵子
	IB-16	SiC膜脱離を活用したSiCエピ成長装置の短時間クリーニング	羽深 等
	IB-17	貼り合わせSiC基板を用いた熱処理不要なオーミックコンタクトの実現	石川 誠治
	IB-18	3C-SiC多結晶と4H-SiC単結晶の貼り合わせ基板上に形成されたパワーデバイスのI-V特性評価	霜野 貴也
	IB-19	X線トポグラフィーによるイオン注入SiCの結晶反りと膨張の相関の証拠	石地 耕太郎
	IB-20	3層構造4H-SiCのイオン注入層の非接触・非破壊電気特性測定	佐藤 希一
	IB-21	ヘイズ最適化によるSiO ₂ /GaN界面の改質	上沼 睦典